



三洋半導体
ニュース

No.1399

8043

2SC3484

シリコン NPN 三重拡散アレーナ型トランジスタ

高精細度CRTディスプレイ水平偏向出力用

特長 ・高耐圧、高信頼性である。

・スイッチングスピードが速い: $t_f = 0.3 \mu s \text{ max.}$

・一点止め樹脂モールドパッケージで 取り付け作業性が良い。

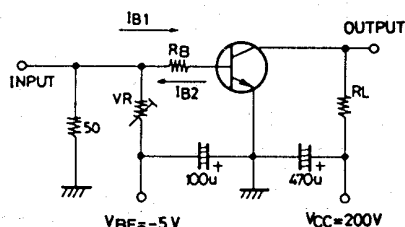
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a = 25^\circ C$

			unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	7	V
コレクタ電流	I_C	3.5	A
ピークコレクタ電流	i_{cp}	10	A
コレクタ損失	P_C	80	W
	$T_C = 25^\circ C$		
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存周囲温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a = 25^\circ C$

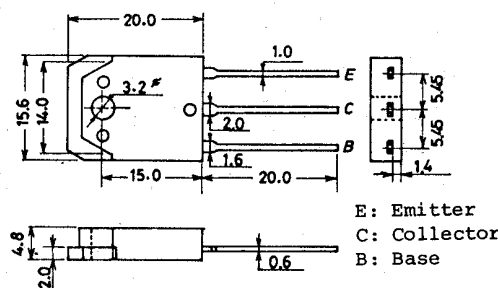
			min	typ	max	unit
コレクタ・シャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = 800V, I_E = 0$			10	μA
エミッタ・シャ断電流	I_{EB0}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$			1	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 0.5A$	8			
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 10V, I_C = 0.5A$		3		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2.5A, I_B = 0.8A$			8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 2.5A, I_B = 0.8A$			1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C = 5mA, I_E = 0$	1500			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = 5mA, R_{BE} = \infty$	800			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = 5mA, I_C = 0$	7			V
蓄積時間	t_{stg}	$I_C = 3A, I_{B1} = 0.8A,$			3.0	μs
下降時間	t_f	$I_{B2} = -1.6A,$			0.3	μs
		$R_L = 66.7\Omega$				

スイッチングタイム測定回路

 $PW = 20\mu s, \text{Duty} \leq 1\%$ 

外形図 2022

(unit: mm)



E: Emitter
C: Collector
B: Base

* これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町坂田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

TEL 0276-63-2111 (大代表)